

U232

N-Channel Dual Silicon Junction Field-Effect Transistor

- Differential Amplifier
- Low & Maximum Frequency Amplifier

Absolute maximum ratings at $T_A = 25^\circ\text{C}$

Reverse Gate Source & Gate Drain Voltage	-50V
Continuous Forward Gate Current	50 mA
Continuous Device Power Dissipation	300 mW
Power Derating	1.7 mW/ $^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	-65 $^\circ\text{C}$ to +150 $^\circ\text{C}$

At 25 $^\circ\text{C}$ free air temperature

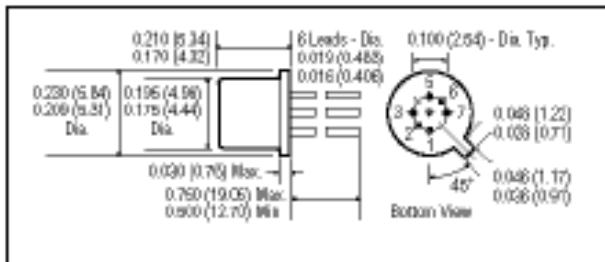
Static Electrical Characteristics

		U232			Process NJ16		
		Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions	
Gate Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)GSS}$	-50			V	$I_G = -1 \mu\text{A}$, $V_{DS} = 0 \text{ V}$	
Gate Reverse Current	I_{GSS}			-0.1	nA	$V_{GS} = -10 \text{ V}$, $V_{DS} = 0 \text{ V}$	
Gate Source Cutoff Voltage	$V_{GS(OFF)}$	-0.5		-4.5	V	$V_{DS} = 10 \text{ V}$, $V_{GS} = 0 \text{ V}$	
Drain Saturation Current (pulsed)	I_{DSS}	0.5		5	mA	$V_{DS} = 10 \text{ V}$, $V_{GS} = 0 \text{ V}$	

Dynamic Electrical Characteristics

Common-Source Forward Transconductance	g_{fs}	1		3	mS	$V_{DS} = 10 \text{ V}$, $V_{GS} = 0 \text{ V}$	$f = 1 \text{ kHz}$
Common-Source Input Capacitance	C_{iss}			6	pF	$V_{DS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 5 \text{ mA}$	$f = 1 \text{ MHz}$
Common-Source Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}			2	pF	$V_{DS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 5 \text{ mA}$	$f = 1 \text{ MHz}$
Equivalent Short Circuit Input Noise Voltage	$\sim e_N$			80	nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$	$V_{DS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 5 \text{ mA}$	$f = 100 \text{ Hz}$

Matching Characteristics		Min	Max	Units	Test Conditions
Differential Gate-Source Voltage	$(V_{GS1} - V_{GS2})$		10	mV	$V_{DS} = 10 \text{ V}$, $I_D = -10 \text{ mA}$
Differential Gate Source Voltage with Temperature	$\frac{\Delta(V_{GS1} - V_{GS2})}{\Delta T}$		25	$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$	$V_{DS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 30 \mu\text{A}$



TO-71 Package
 Dimensions in inches (mm)
Pin Configuration
 1 Source, 2 Drain, 3 Gate,
 5 & 6 Drain, 6 Drain, 7 Gate

Surface Mount Version:
 SMPU232



715 N. Glenville Dr., Ste. 400
 Richardson, TX 75089
 (972) 238-9700 Fax (972) 238-5338

www.interfet.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.